NGTB10N60R2DT4G RC-IGBT アプリケーションノート

冷蔵庫コンプレッサ、ファンモータ向け

1. 初めに

RC-IGBT は Reverse Conducting Insulated Gate Bipolar Transistor の略であり、FWD を同ーチップにビルトインした IGBT です。インバータ回路の様にIGBTとFWDが必要な場合1chipとなるので、パッケージが小さくでき、両者は熱的なバランスもとれます。

この資料ではDPakを使用したRC-IGBTの動作 アプリケーションを紹介します。

2. RC-IGBTとIGBTの断面構造 (一般説明)

表.1にIGBTチップとの構造、動作の相似/相違点を表にまとめ、断面構造の比較を示します。

RC-IGBTは裏面の一部をN+(高濃度のN層)で 形成することによりダイオードを形成し、回路的 にはコレクタ(C)側がカソード、エミッタ



ON Semiconductor®

www.onsemi.jp

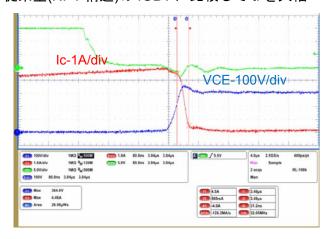
(E)側がアノードとなり、回路的には IGBT のフリーフォイールダイオード(FWD)として機能させることができます。もちろんダイオードとしては高速設計をしており、trr<90ns と高速性能を確保しています。さらに今回の RC-IGBT は当社の FS2 構造も取り入れた構造でありこのプロセスは RC2-IGBT と呼んでいます。

表.1 RC-IGBT と IGBT の構造比較

チップ構造	RC-IGBT FRD エリアは裏面の P+層の一部 N+層に 置換えることにより形成している	IGBT 裏面一面が P+層となっている。 FRD は別のチップ
回路記号		
チップ断面(一般的な構造での説明)	Emitter metal P- N IGBT Area FRD Area P+ N+ IGBT contact Diode contact	Emitter metal P- N IGBT Area P+ IGBT contact

3. RC2-IGBT の高速 SW 性能について

FS2 構造は元々高速スイッチング用途例えば フルスイッチング PFC 用途の IGBT に向けて ONsemi が開発したプロセスです。この構造を 今回開発した RC2-IGBT に採用することにより 従来型(NPT 構造)の IGBT に比較して tf を大幅



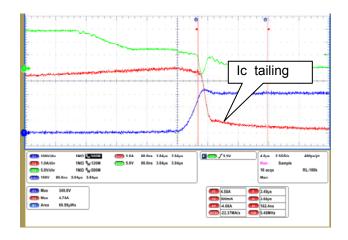
WP.1 FS2-IGBT Ic=5A tf=31.2ns

4. RC2-IGBT の製品ラインアップについて

RC2-IGBTはIGBTとFRDを1チップにしたことで小型化出来るという特徴があるので、 ONsemiではその特徴を生かし、DPak品を中心にラインアップを構成しています。

表.2 RC2-IGBT ラインアップ

に改善(高速化)出来ました。動作波形例をWP.1 と2に示します。WP.1がRC2-IGBTの5A動作時 のtf波形であり、WP.2の10AスペックNPT品に 比較して高速でtfテーリングもない動作を実現 しています。



WP.2 NPT-IGBT Ic=5A tf=102ns

Ic定格電流はコンパクトなパッケージで、 NGTB03N60R2DT4GのIc=4.5A、から NGTB10N60R2DT4GではIc=10Aを実現し ています。

		Absolute maximum ratings			Electrical characteristics /Ta=25°C		ectrical eristics /	
			IC	IC	ICP	VCE(sat)		
			@Tc=	@Tc=	@Tc=		VF	trr
		VCES	25°C	100°C	25°C	typ	typ	typ
Type No.	Package	[V]	[A]	[A]	[A]	[V]	[V]	[ns]
NGTB03N60R2DT4G	DPAK		9	4.5	12	1.7(3A)	1.5	65*1
NGTB05N60R2DT4G	DPAK	600	16	8	20	1.65(5A)	1.5	75*1
NGTB10N60R2DT4G	DPAK	600	20	10	40	1.7(10A)	1.5	90*1
NGTB15N60R2FG	TO-220F-3FS		24	14	60	1.85(15A)	1.7	95*1

^{*1} IF=Ic(Tc=100°C), VR=300V, di/dt=300A/µs

5. RC-IGBTのアプリケーションマップ

DPAK外形のNGBT10N60R2DT4Gを中心と するアプリケーションマップを示します。 (Fig.1) 冷蔵庫や動作周波数が高め(15kHz)のファンモータにも最適です。

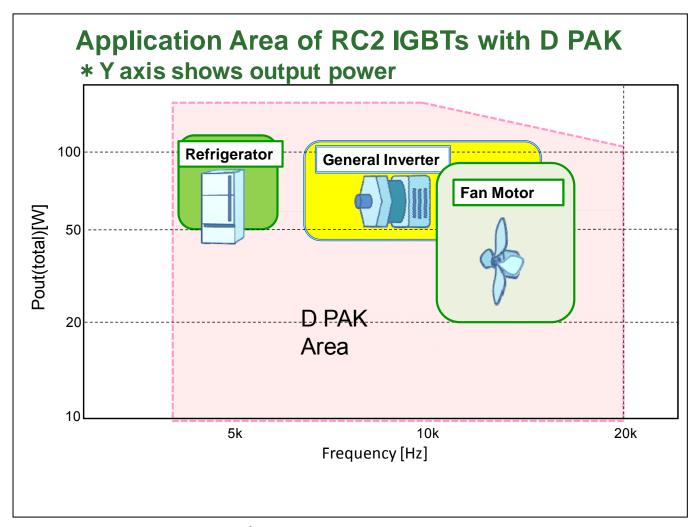


Fig.1 RC-IGBT (D PAK 品) のアプリケーションエリア

6. BLDCモータでの動作

6-1) 他社製品とのDC定格の比較

冷蔵庫のコンプレッサに使用されている他社 IGBTと主なDC定格の比較を表.2に示します。 NGTB05N60R2DT4G、10N60R2DT4Gとも A IGBTよりVCE(sat)値が低く、導通ロスを下げることができます。

表.2 IGBT DC スペック 他社との比較

	Ic[A] @Tc=100°C	VCE(sat) [V]	VF [V]
NGTB05N60R2DT4G	8.0	1.65(5A)	1.5(5A)
NGTB10N60R2DT4G	10.0	1.7(10A)	1.7(10A)
A IGBT	4.2	1.9(3A)	1.9(3A)

6-2) BLDCモータでの動作実験

Fig.3の回路構成で3相BLDCモータを駆動した時の動作温度特性をFig.2に示します。(120° PWM駆動、fc=6.8kHz) PCBに実装された各IGBTの動作温度Tcを測定した結果です。上記DC定格の様に、IGBT AよりVCE(sat)が低いNGTB 05N60R2、10N60R2とも温度が下がっています。特に定格電流の大きいNGTB10N60R2DT4Gは、05N60R2DT4Gより更に5~8°Cも温度が下がっており、10N60R2DT4Gであれば、セットは更に

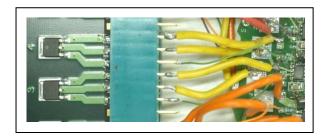


Photo.1 動作検討基板(一部)

大きい出力が可能になります。冷蔵庫であれば より容量の大きいセットをカバーできることに なります。

測定基板の素子実装状態と動作検討基板 (一部)をPhoto.1に示します。

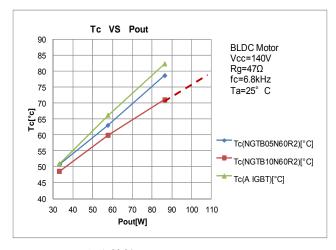


Fig.2 動作特性 Tc VS Ic

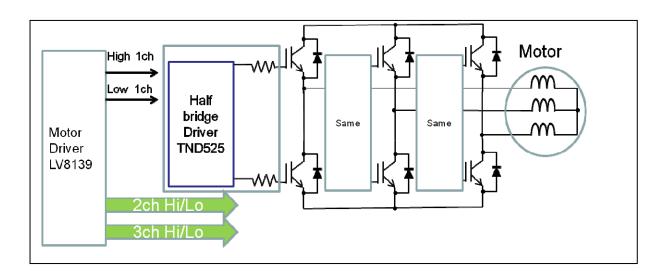


Fig.3 動作回路ブロック